

To all our customers

Regarding the change of names mentioned in the document, such as Mitsubishi Electric and Mitsubishi XX, to Renesas Technology Corp.

The semiconductor operations of Hitachi and Mitsubishi Electric were transferred to Renesas Technology Corporation on April 1st 2003. These operations include microcomputer, logic, analog and discrete devices, and memory chips other than DRAMs (flash memory, SRAMs etc.)

Accordingly, although Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Semiconductors, and other Mitsubishi brand names are mentioned in the document, these names have in fact all been changed to Renesas Technology Corp. Thank you for your understanding. Except for our corporate trademark, logo and corporate statement, no changes whatsoever have been made to the contents of the document, and these changes do not constitute any alteration to the contents of the document itself.

Note : Mitsubishi Electric will continue the business operations of high frequency & optical devices and power devices.

Renesas Technology Corp.
Customer Support Dept.
April 1, 2003

FK20UM-5

HIGH-SPEED SWITCHING USE

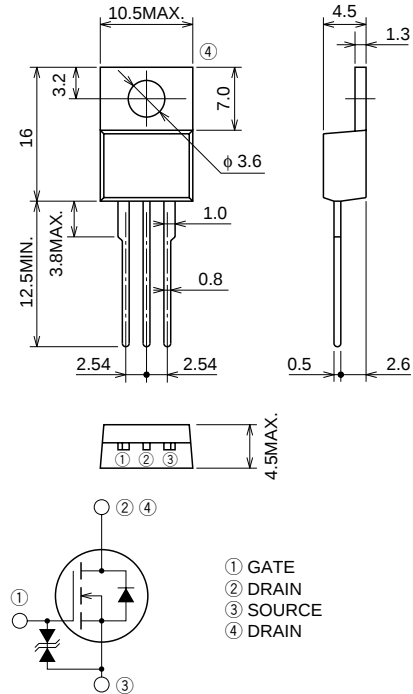
FK20UM-5



- V_{DS} 250V
- $r_{DS(ON)}$ (MAX) 0.24Ω
- I_D 20A
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) 150ns

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



TO-220

APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.

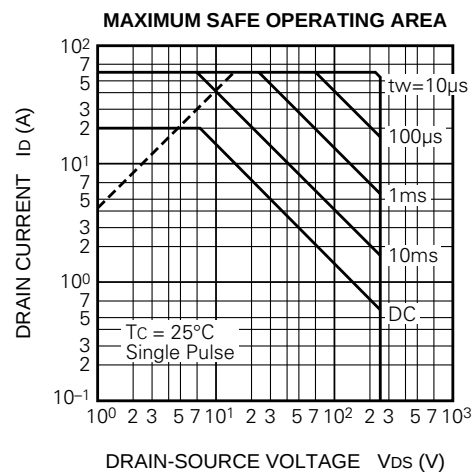
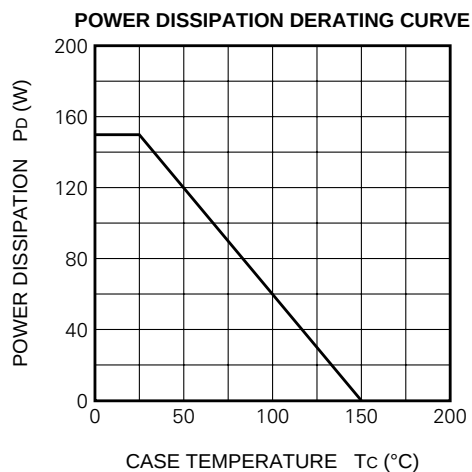
MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C)

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V_{DS}	Drain-source voltage	$V_{GS} = 0V$	250	V
V_{GSS}	Gate-source voltage	$V_{DS} = 0V$	± 30	V
I_D	Drain current		20	A
I_{DM}	Drain current (Pulsed)		60	A
I_S	Source current		20	A
I_{SM}	Source current (Pulsed)		60	A
P_D	Maximum power dissipation		150	W
T_{ch}	Channel temperature		-55 ~ +150	°C
T_{stg}	Storage temperature		-55 ~ +150	°C
—	Weight	Typical value	2.0	g

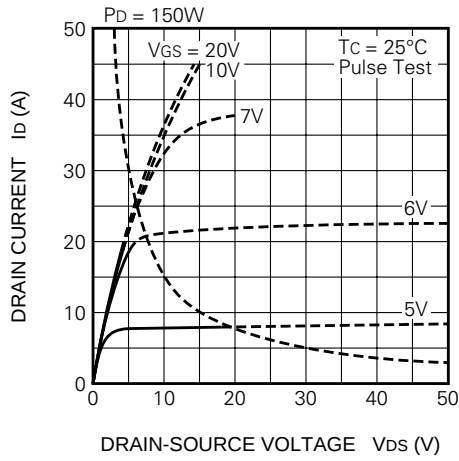
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{ch} = 25°C)

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
V (BR) DSS	Drain-source breakdown voltage	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	250	—	—	V
V (BR) GSS	Gate-source breakdown voltage	I _G = ±100μA, V _{DS} = 0V	±30	—	—	V
I _{GSS}	Gate-source leakage current	V _{GS} = ±25V, V _{DS} = 0V	—	—	±10	μA
I _{DSS}	Drain-source leakage current	V _{DS} = 250V, V _{GS} = 0V	—	—	1	mA
V _{GS} (th)	Gate-source threshold voltage	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	2	3	4	V
r _{DS} (ON)	Drain-source on-state resistance	I _D = 10A, V _{GS} = 10V	—	0.19	0.24	Ω
V _{DS} (ON)	Drain-source on-state voltage	I _D = 10A, V _{GS} = 10V	—	1.9	2.4	V
y _{fs}	Forward transfer admittance	I _D = 10A, V _{DS} = 10V	8.5	13.0	—	S
C _{iss}	Input capacitance	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	1400	—	pF
C _{oss}	Output capacitance		—	280	—	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance		—	55	—	pF
t _d (on)	Turn-on delay time	V _{DD} = 150V, I _D = 10A, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = R _{GS} = 50Ω	—	25	—	ns
t _r	Rise time		—	50	—	ns
t _d (off)	Turn-off delay time		—	150	—	ns
t _f	Fall time		—	65	—	ns
V _{SD}	Source-drain voltage	I _S = 10A, V _{GS} = 0V	—	1.5	2.0	V
R _{th} (ch-c)	Thermal resistance	Channel to case	—	—	0.83	°C/W
t _{rr}	Reverse recovery time	I _S = 20A, di _s /dt = -100A/μs	—	—	150	ns

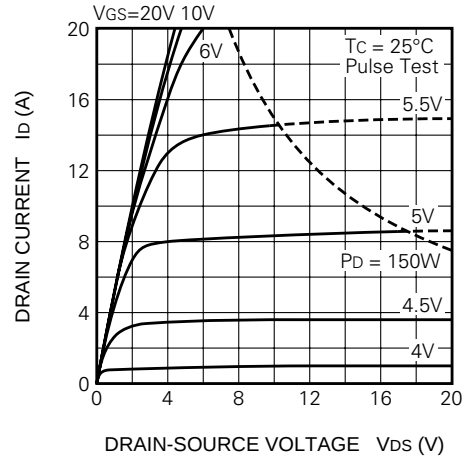
PERFORMANCE CURVES



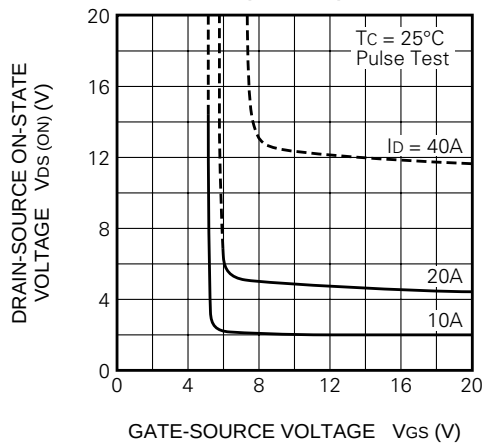
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



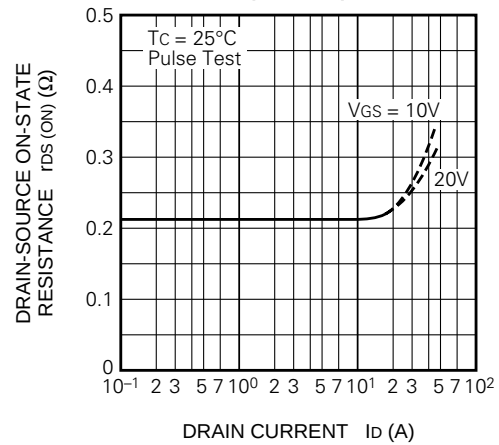
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



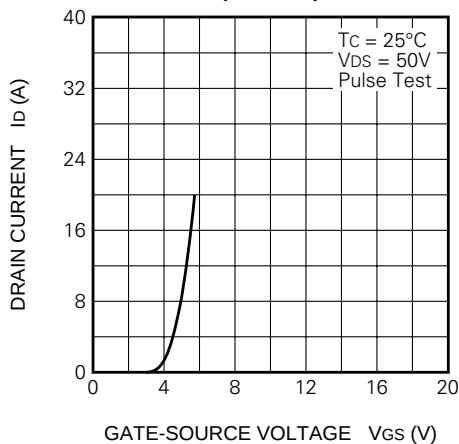
ON-STATE VOLTAGE VS.
GATE-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)



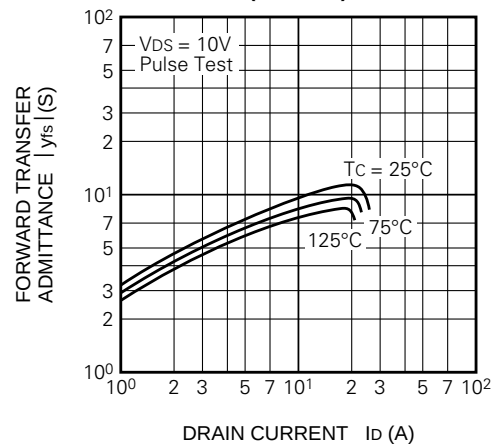
ON-STATE RESISTANCE VS.
DRAIN CURRENT
(TYPICAL)

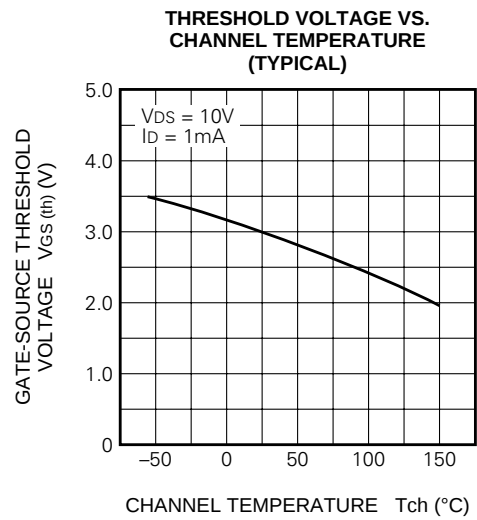
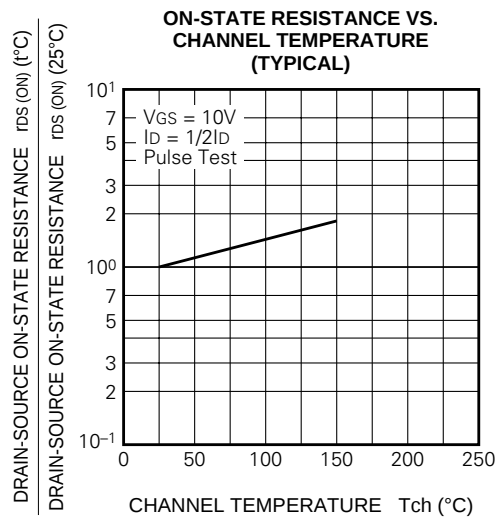
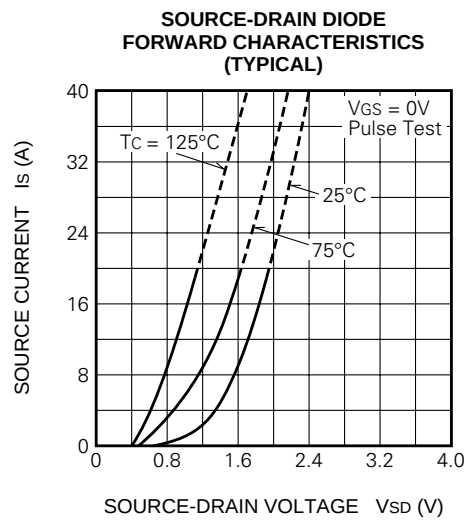
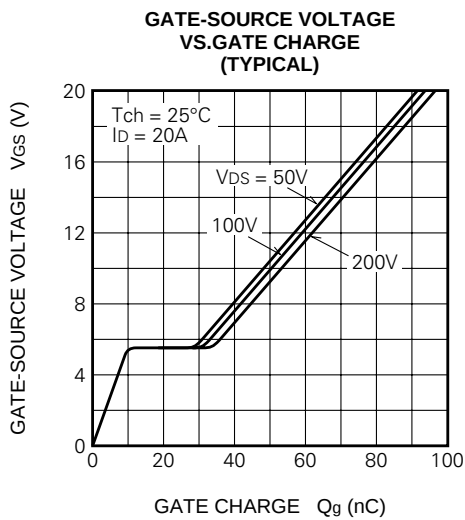
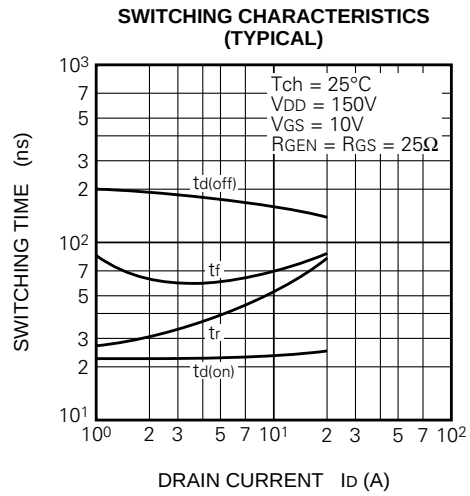
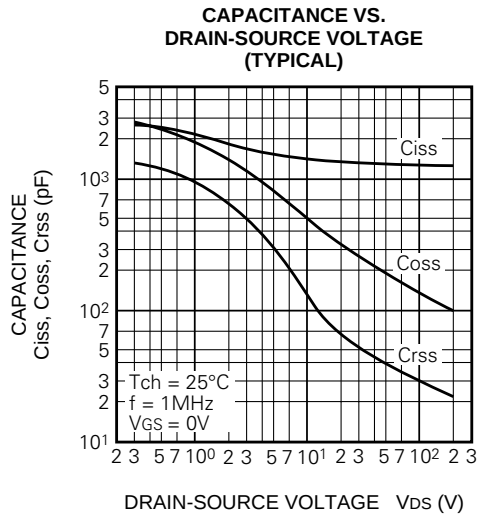


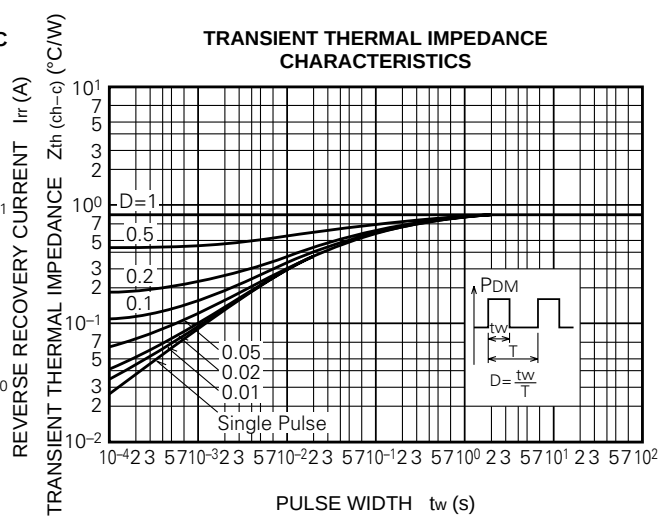
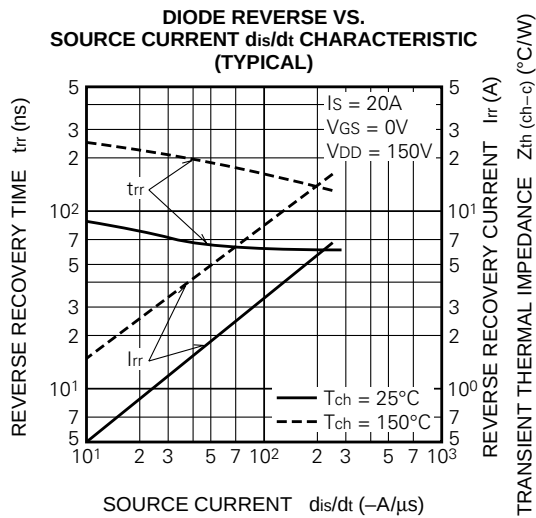
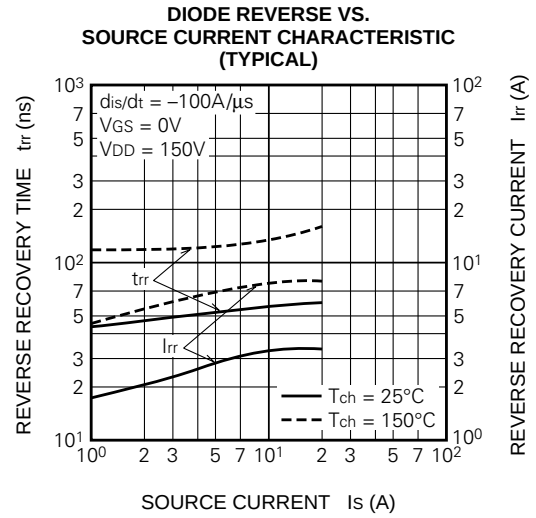
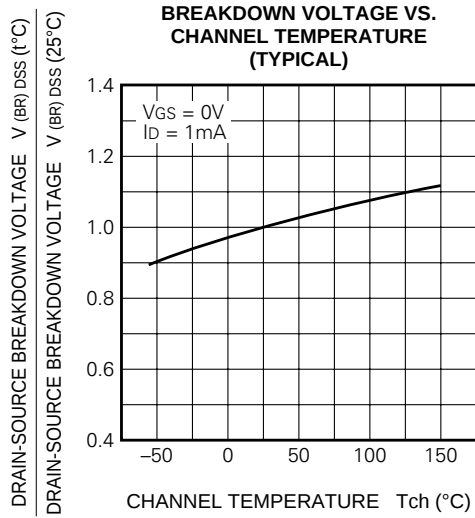
TRANSFER CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
VS.DRAIN CURRENT
(TYPICAL)







Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru